FEATURES

∗0.3 inch (7.62 mm) DIGIT HEIGHT
∗EXCELLENT SEGMENT UNIFORMITY
∗LOW POWER REQUIREMENT
∗HIGH BRIGHTNESS AND HIGH CONTRAST
∗WIDE VIEWING ANGLE
∗SOLID STATE RELIABILITY
∗BINNED FOR LUMINOUS INTENSITY

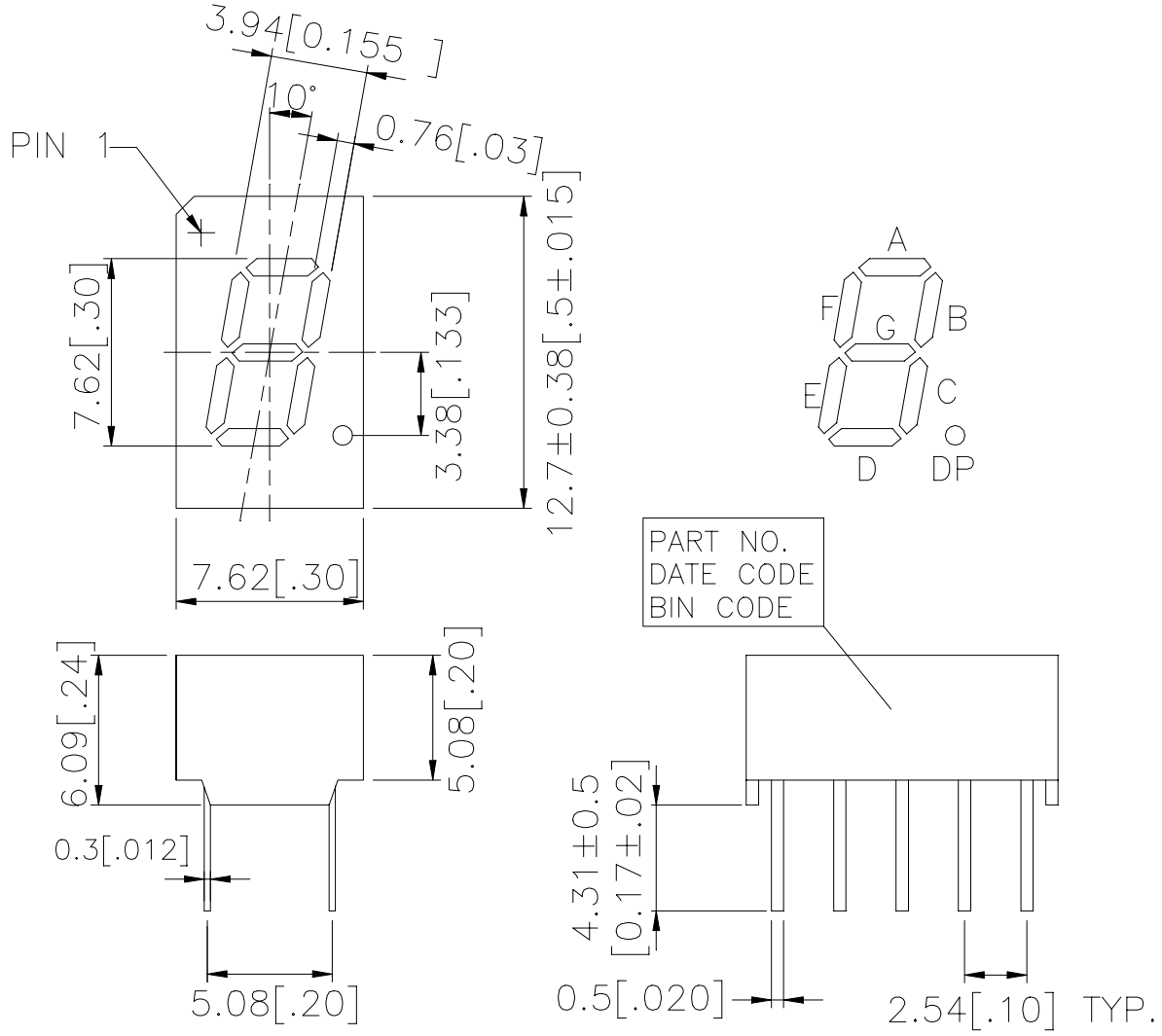
DESCRIPTION

The LSHD-A101 is a 0.3 inch (7.62 mm) digit height single-digit display. This device uses AS-AlInGaP RED LED chips (AlInGaP epi on GaAs substrate). The display has light gray face and white segments.

DEVICE

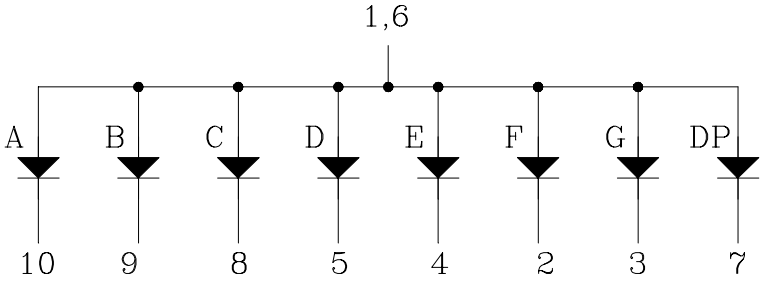
PART NO.	DESCRIPTION
AlInGaP RED	Common Anode
LSHD-A101	Rt. Hande Decimal

PACKAGE DIMENSIONS



NOTES: All dimensions are in millimeters. Tolerances are ± 0.25mm (0.01“) unless otherwise noted.

INTERNAL CIRCUIT DIAGRAM



PIN CONNECTION

No.	CONNECTION
1	Common Anode
2	Cathode F
3	Cathode G
4	Cathode E
5	Cathode D
6	Common Anode
7	Cathode DP
8	Cathode C
9	Cathode B
10	Cathode A

ABSOLUTE MAXIMUM RATING AT Ta = 25°C

PARAMETER	MAXIMUM RATING	UNIT
Power Dissipation Per Segment	70	mW
Peak Forward Current Per Segment (Frequency 1Khz, 15% duty cycle)	90	mA
Continuous Forward Current Per Segment	25	mA
Forward Current Derating from 25^0C	0.28	mA/^{0}C
Reverse Voltage Per Segment	5	V
Operating Temperature Range	-35^0C to +105^0C	
Storage Temperature Range	-35^0C to +105^0C	
Soldering Conditions : 1/16 inch below seating plane for 3 seconds at 260^0C		

ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta = 25°C

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNIT	TEST CONDITION
Average Luminous Intensity Per Segment	I_V	200 3400	692 9000		μcd	I_F = 1mA I_F = 10mA
Peak Emission Wavelength	λp		650		nm	I_F = 20mA
Spectral Line Half-Width	Δλ		20		nm	I_F = 20mA
Dominant Wavelength	λd		639		nm	I_F = 20mA
Forward Voltage Per Segment	V_F		2.1	2.6	V	I_F = 20mA
Reverse Current Per Segment	I_R			100	μA	V_R = 5V
Luminous Intensity Matching Ratio	I_V-m			2 : 1		I_F = 1mA

Note: Luminous Intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commision Internationale De L'Eclairage) eye-response curve.

TYPICAL ELECTRICAL / OPTICAL CHARACTERISTIC CURVES

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

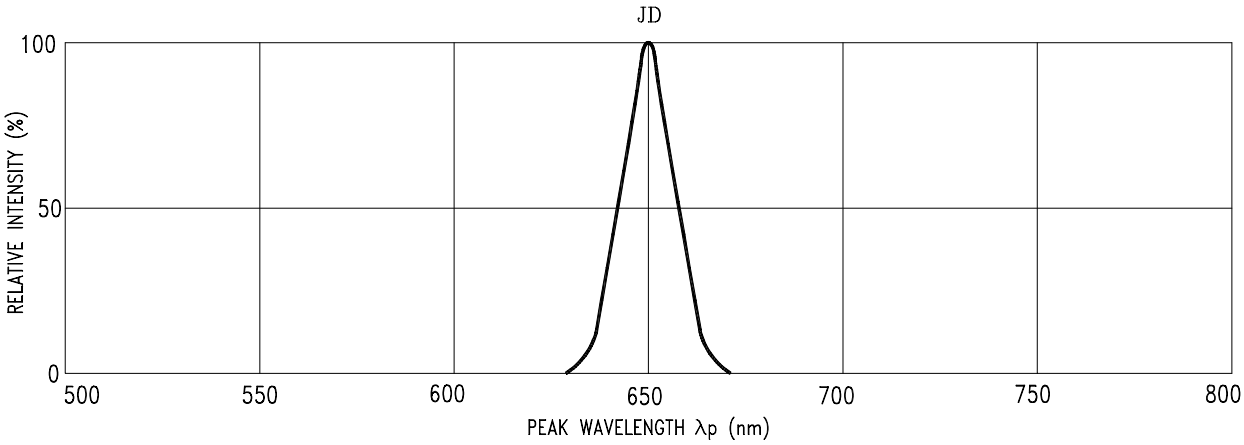


Fig1.Spectral Emission

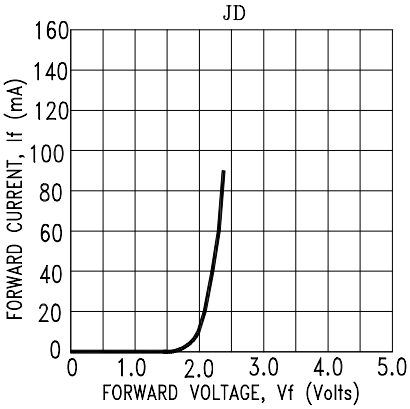


Fig2. Forward Current vs. Forward Voltage

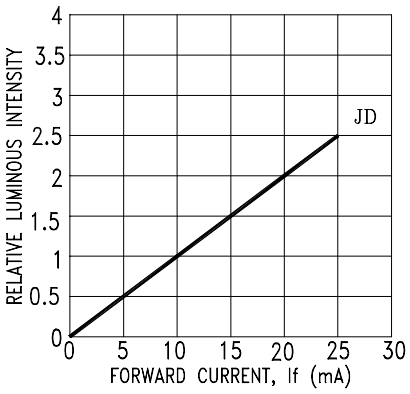


Fig3. Relative Luminous Intensity vs. DC Forward Current

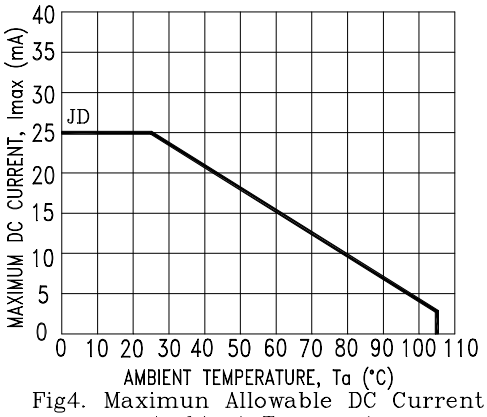


Fig4. Maximun Allowable DC Current vs. Ambient Temperature

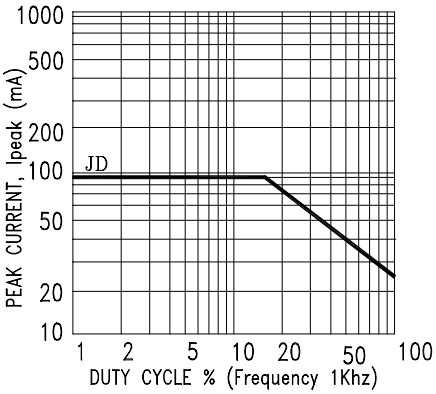


Fig5. Maximum Peak Current vs. Duty Cycle %

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9